

The background of the slide is filled with a pattern of white, three-dimensional cubes. These cubes are arranged in a way that creates a sense of depth and perspective, with some cubes appearing closer and larger, while others are further away and smaller. The cubes are scattered across the entire slide, creating a textured, geometric background.

ememory

力旺電子股份有限公司 (3529)

Feb. 24, 2014

智慧財產權聲明

本文件內之資訊，包括文字、圖片或其他檔案等，其所有權及智慧財產權皆屬力旺電子所有，本文件之內容包含力旺電子之機密資訊。請尊重智慧財產權，並予以保密，在未取得力旺電子書面同意前，不得複製、使用本文件或將其揭露予第三人。

eMemory, NeoBit, NeoFuse, NeoFlash, NeoEE與NeoMTP皆為力旺電子在台灣或其他國家之註冊商標或服務標章。

大綱

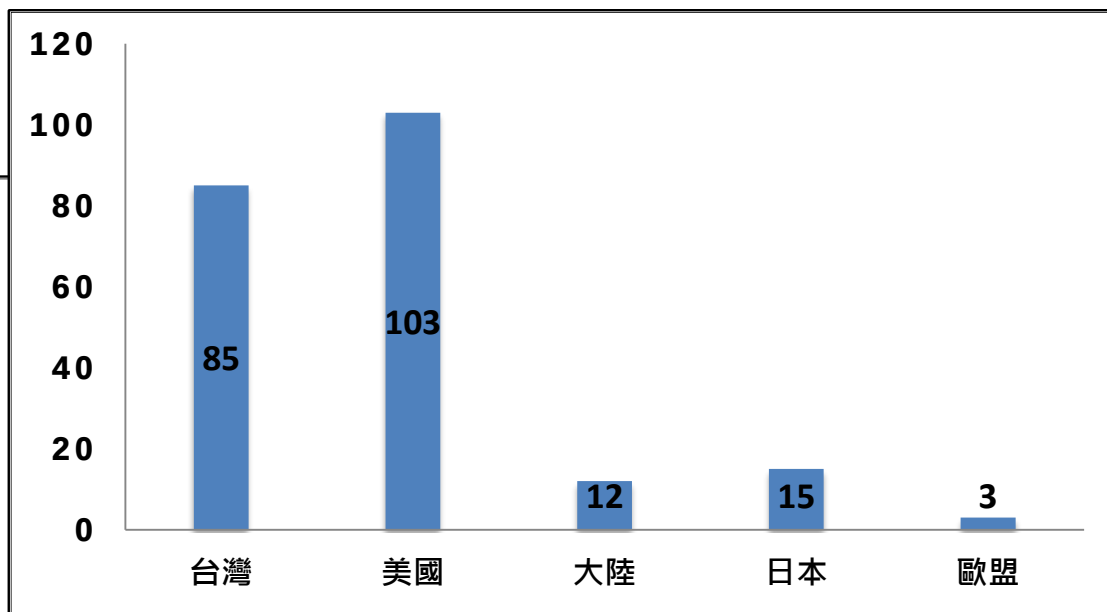
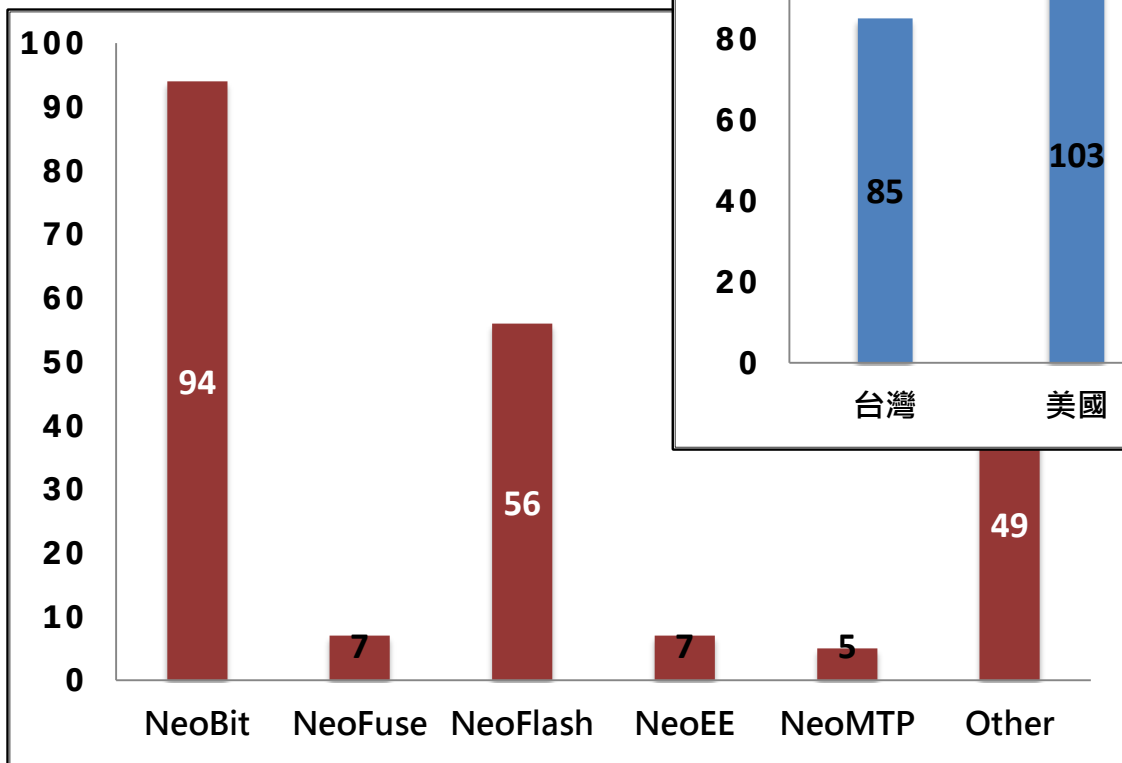
- 公司簡介
- 公司產品佈局
- 營運概況
- 主要產品應用
- 未來展望

公司簡介

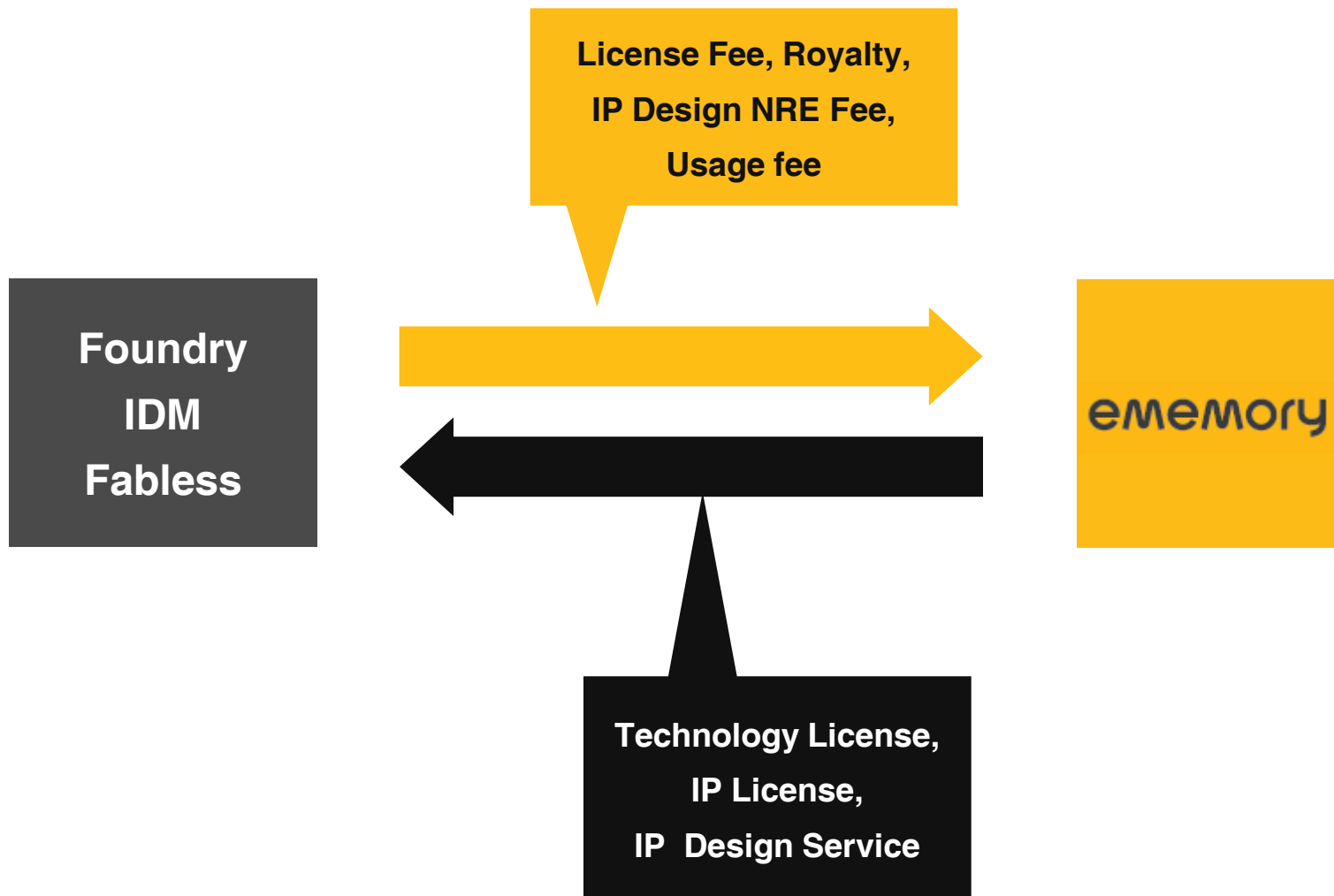
- 公司名稱：力旺電子股份有限公司
- 設立日期：2000年09月02日
- 上櫃日期：2011年01月24日
- 主要產品：矽智財技術授權及IP技術服務
- 實收資本：新台幣768,323仟元
- 員工人數：211人

專利取得

總計218件，2013/12



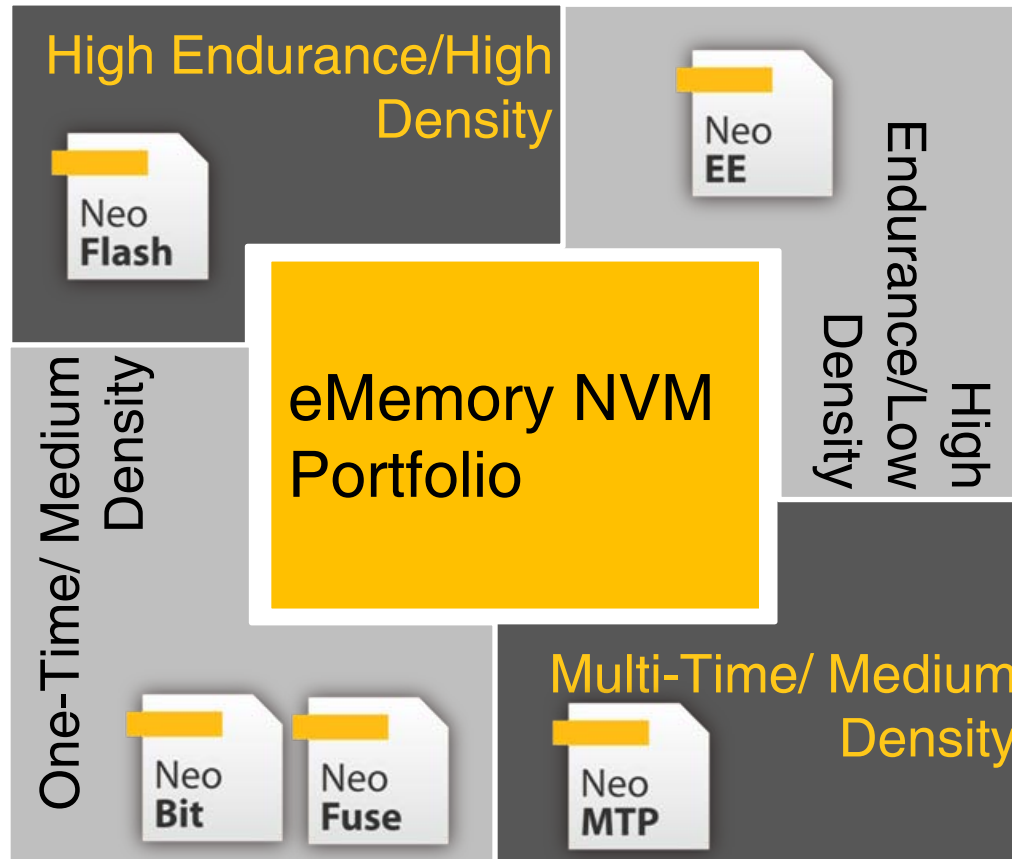
營運模式



大綱

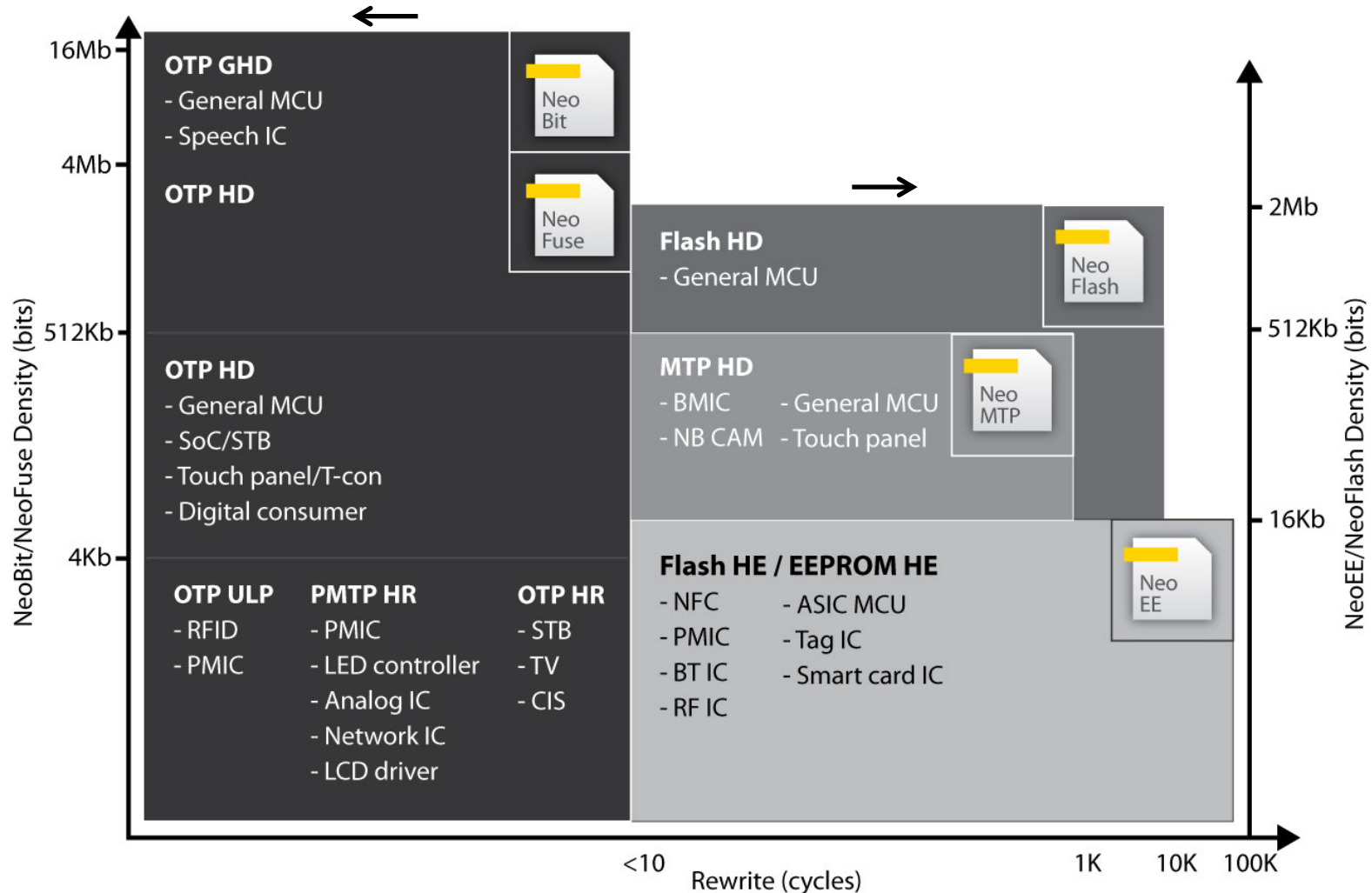
- 公司簡介
- 公司產品佈局
- 營運概況
- 主要產品應用
- 未來展望

產品佈局

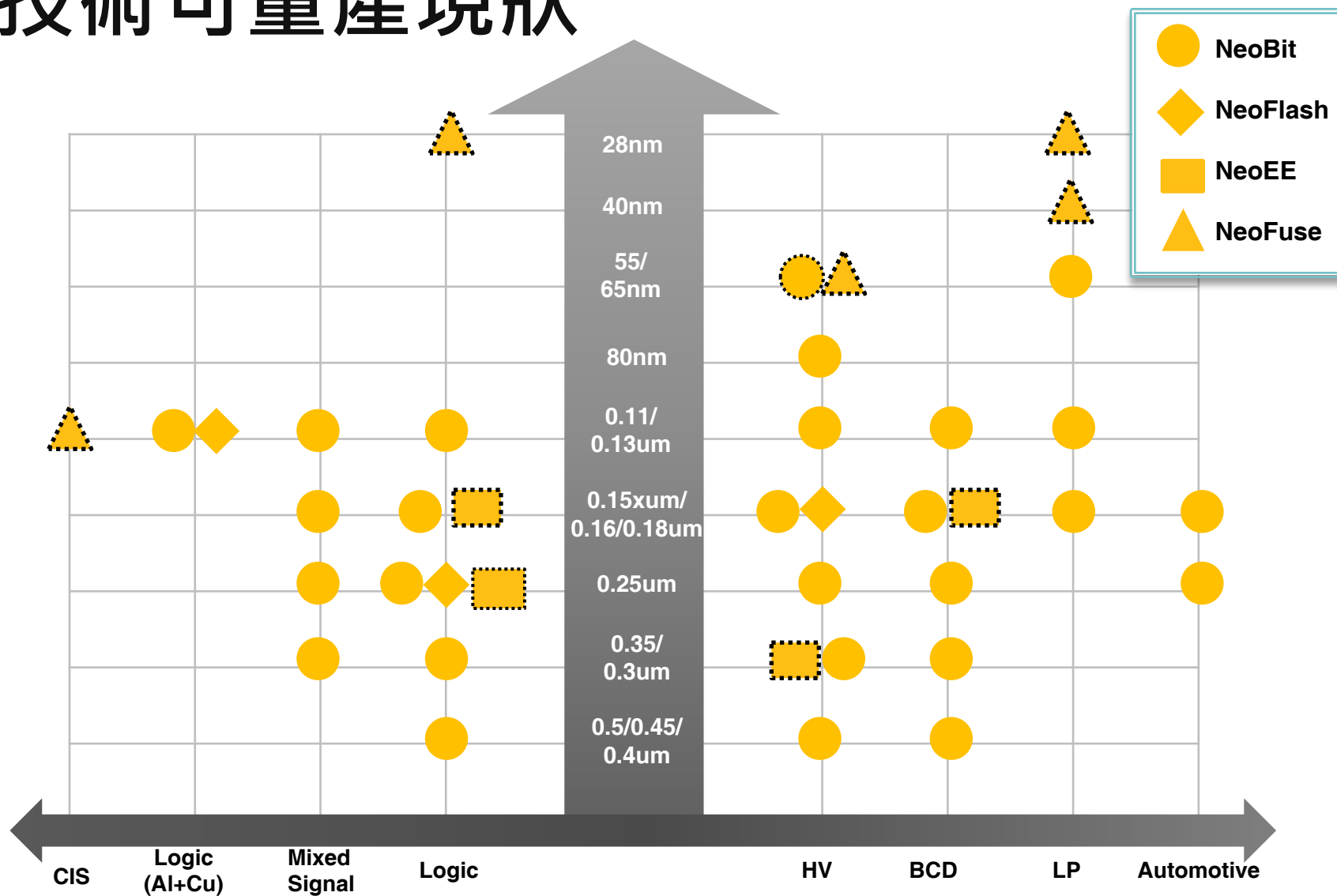


技術佈局

- Wide selection of embedded NVM brings up with wide application.



技術可量產現狀



大綱

- 公司簡介
- 公司產品佈局
- 營運概況
- 主要產品應用
- 未來展望

全球客戶



	Taiwan	China	Korea	Japan	North America	Europe	Others
Foundry	5	6	2	2	1	0	1
IDM	0	0	0	8	2	1	0
Fabless	191	226	38	20	115	66	32

代工廠



元件整合大廠 (IDM)



2012-2013營收比較

單位：台幣 元

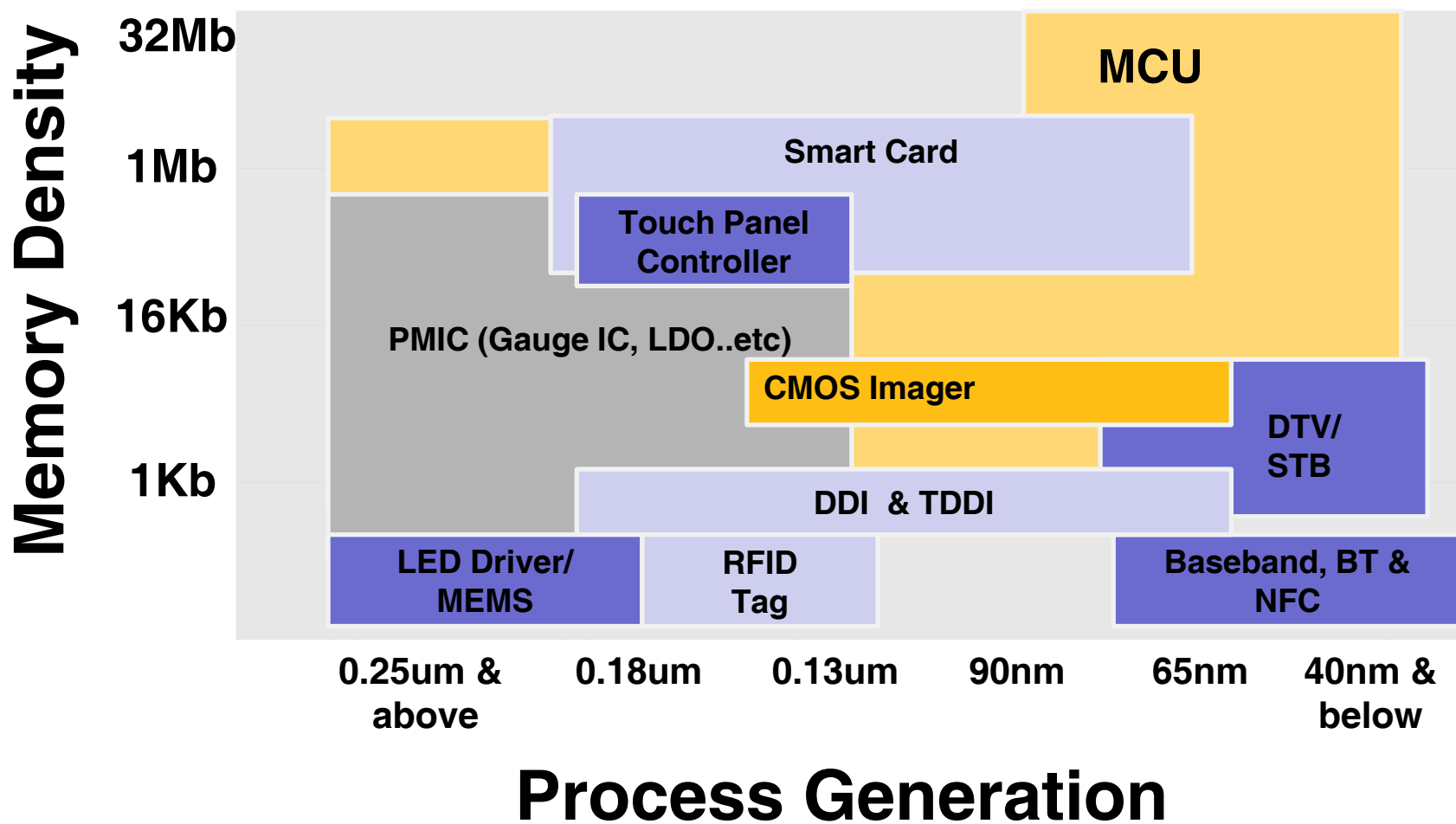
2012	Q1	Q2	Q3	Q4
Usage Fee	13,680,811	13,523,007	12,831,514	16,312,694
NRE Fee	19,490,650	18,123,371	14,101,264	9,820,958
License Fee	24,150,500	24,835,713	9,253,805	8,758,564
Royalty	100,291,035	89,923,908	115,297,903	120,047,575
IP Total	157,612,996	146,405,999	151,484,486	154,939,791

2013	Q1	Q2	Q3	Q4
Usage Fee	13,300,521	19,508,758	21,098,140	20,107,890
NRE Fee	17,358,599	16,558,735	11,555,380	17,850,628
License Fee	20,092,625	44,880,725	24,401,280	18,973,980
Royalty	114,160,341	126,491,360	148,297,470	173,621,244
Total	164,912,086	207,439,578	205,352,270	230,553,742

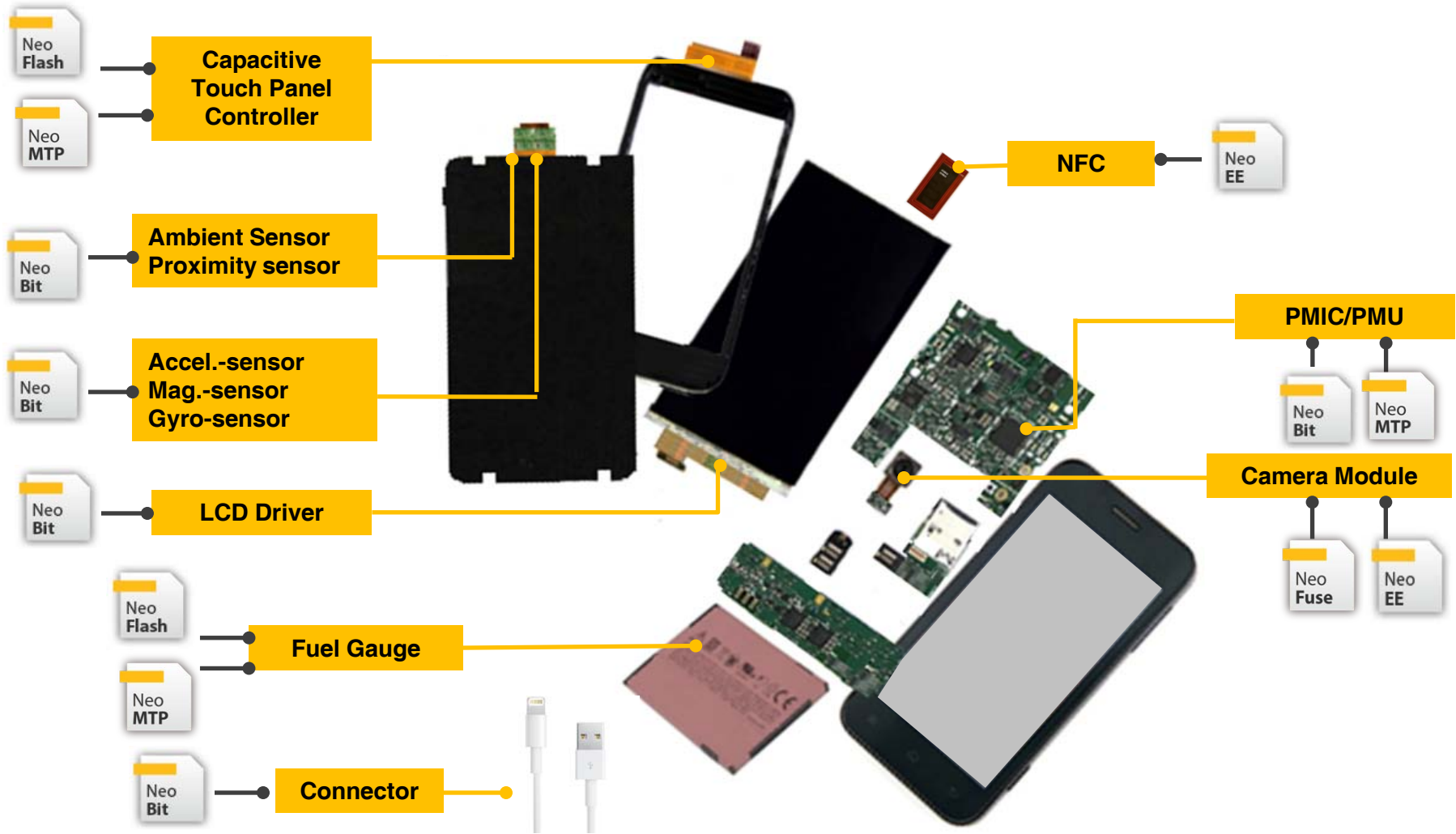
大綱

- 公司簡介
- 公司產品佈局
- 營運概況
- 主要產品應用
- 未來展望

客戶產品應用

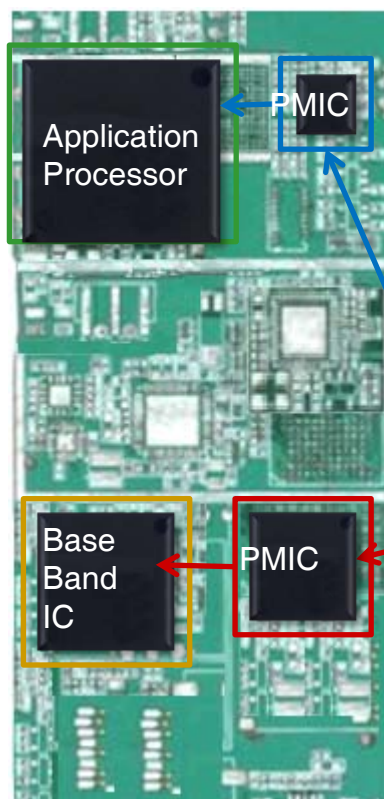


平板手機中力旺產品的應用



基頻與中央處理器之專用電源管理晶片

製程技術: 高階 0.25um BCD/ 0.18um BCD/ 0.13um BCD
低階 0.18um/0.16um/0.152um Logic



Density	NVM Type	Purpose	NVM Usage
2Kb~4Kb	OTP	Trimming	DC/DC, Bandgap
		Parameter Setting	Design flexibility & Performance optimization
		Code Storage	Start-up behavior & smart power saving algorithm

電源管理IC

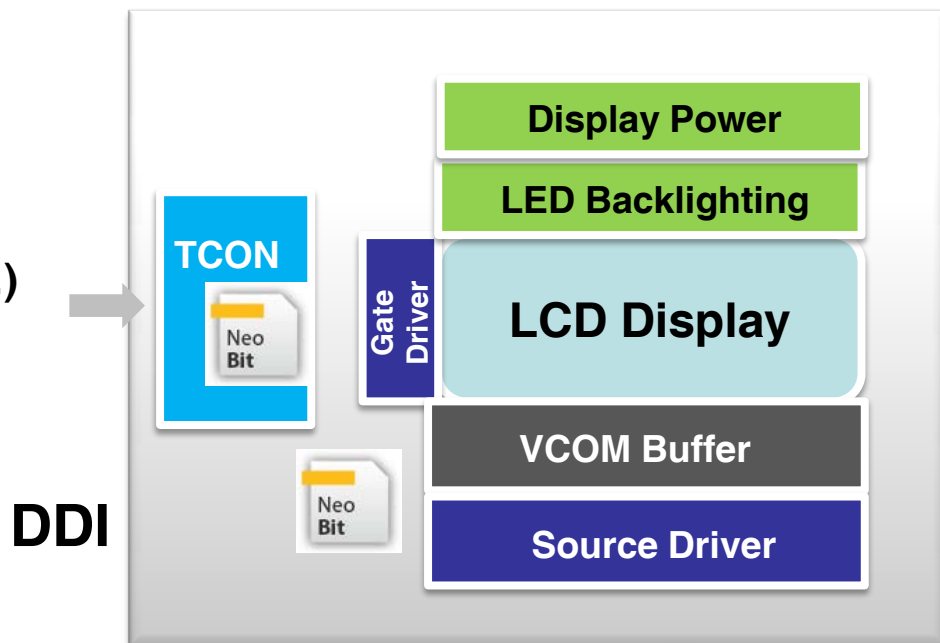


高階顯示驅動晶片

製程技術: 0.11 μ m HV/80nm HV/55nm HV



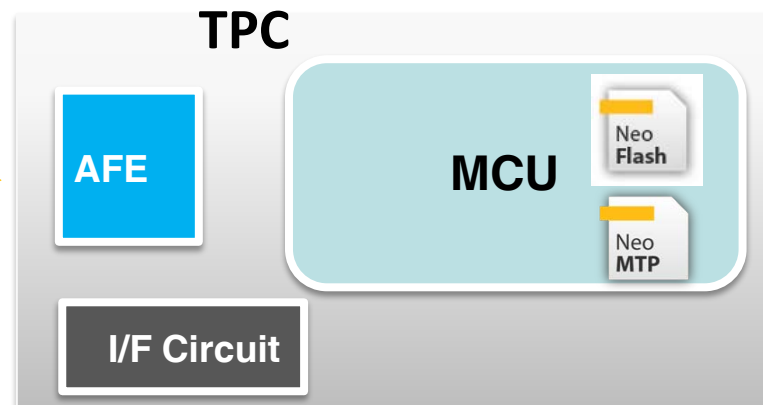
I/F
(LVDS, MIPI,...)



Density	Endurance	NVM Type	Purpose	NVM Usage
2K8~4K8	1	OTP	Trimming	1. Accuracy enhancement 2. Mismatch cancellation
			Code Storage	1. Gamma Correction Table 2. Timing Control Pattern 3. Color Engine Enhancement

觸控晶片

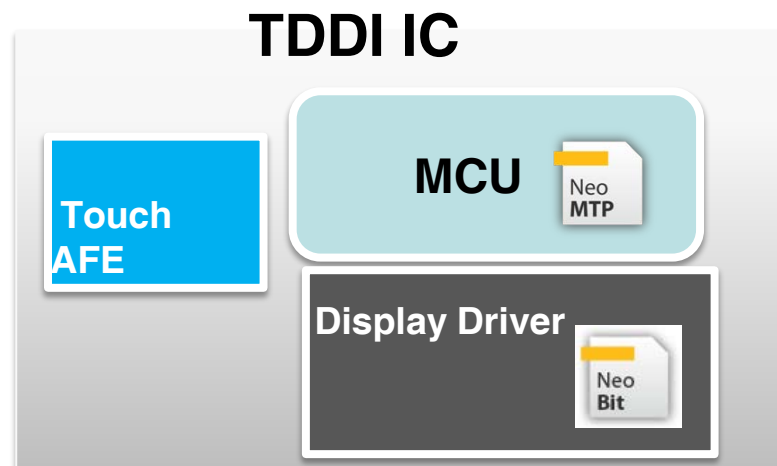
製程技術: 0.16um HV/0.11um G



Density	Endurance	NVM Type	Purpose	NVM Usage
16K8~32K8	<1000	MTP	Code Storage	F/W code
			Parameter setting	Customized model and performance optimization

In-Cell觸控晶片

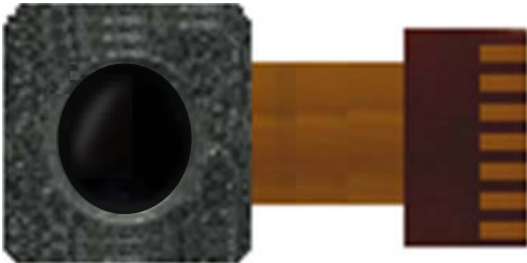
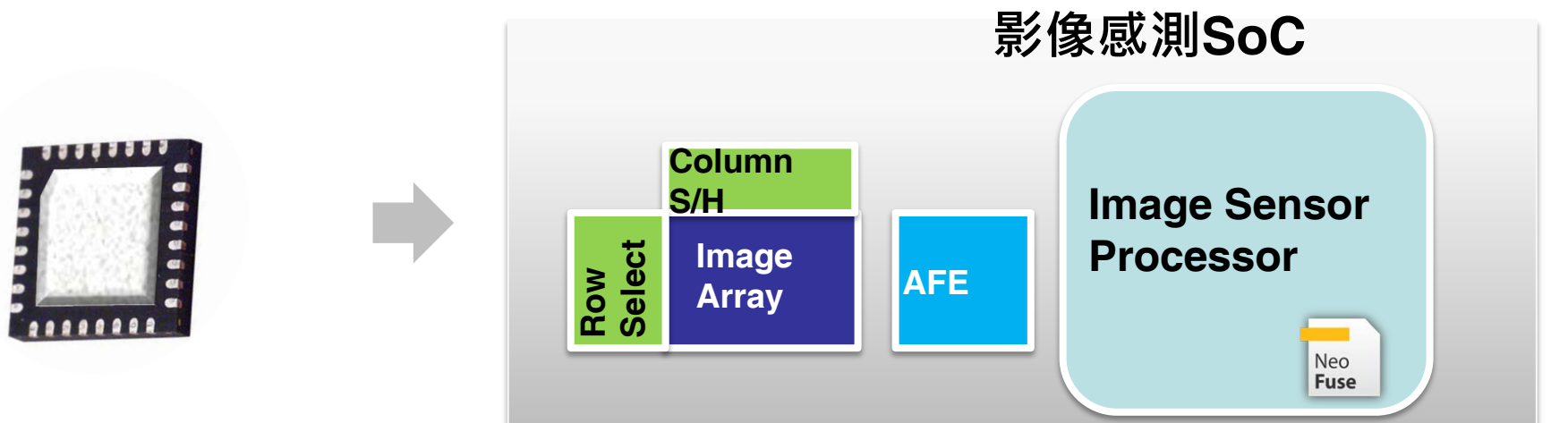
製程技術: 0.11um HV/80nm HV/55nm HV



Density	Endurance	NVM Type	Purpose	NVM Usage
2K8~4K8	1	OTP	Trimming	Accuracy
			Code Storage	Gamma Table
16K8~32K8	<1000	MTP	Code Storage	Touch F/W Code
			Parameter setting	Performance Optimization

影像感測晶片

製程技術: 0.11um CIS/90nm CIS/65nm CIS

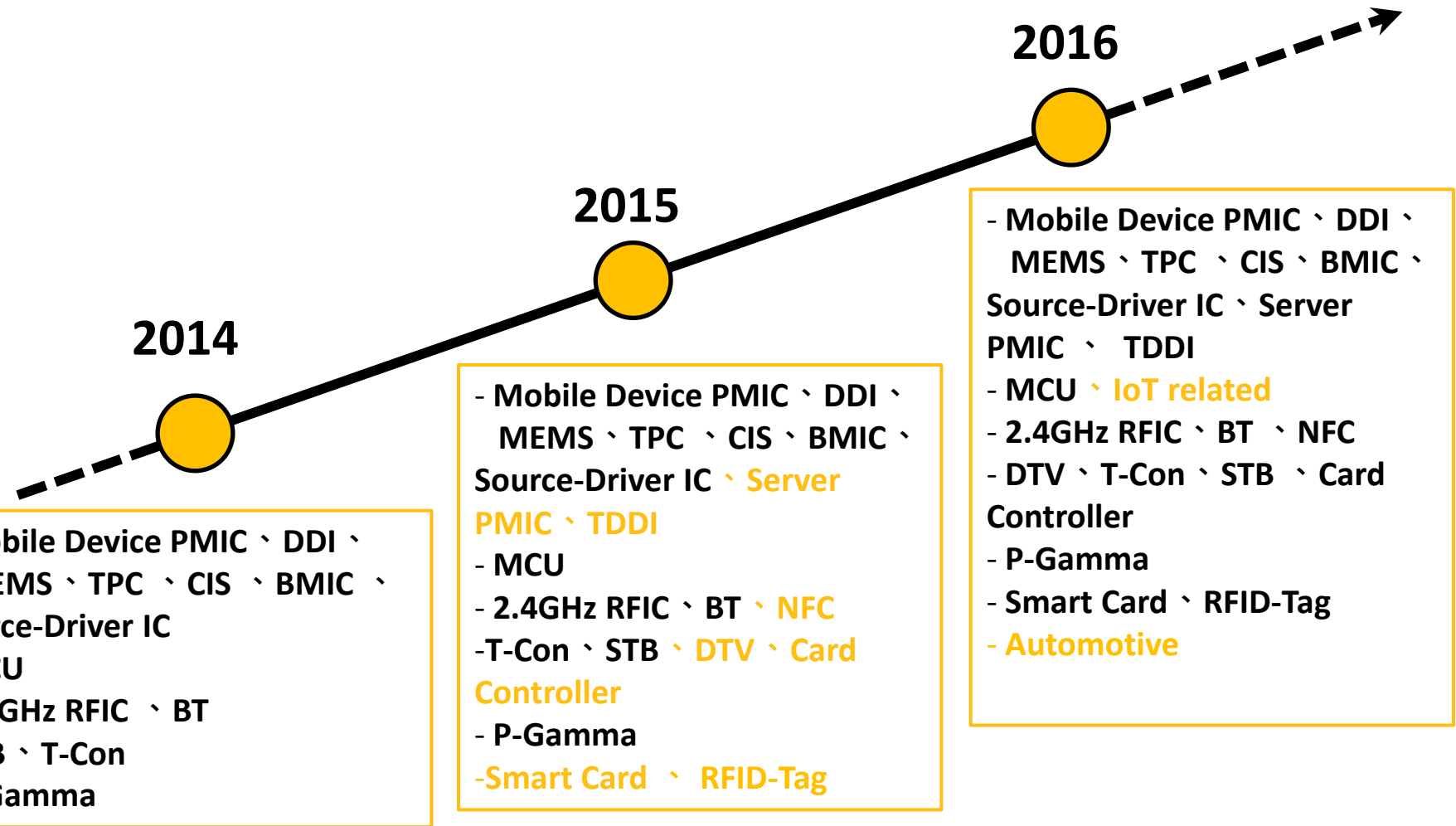


Density	Endurance	NVM Type	Purpose	NVM Usage
2Kb~4Kb	1	OTP	Identification Setting	Product code
			Parameter Setting	Start-up initial setting
32K8	1	OTP/ROM	Code Storage	Boot load

大綱

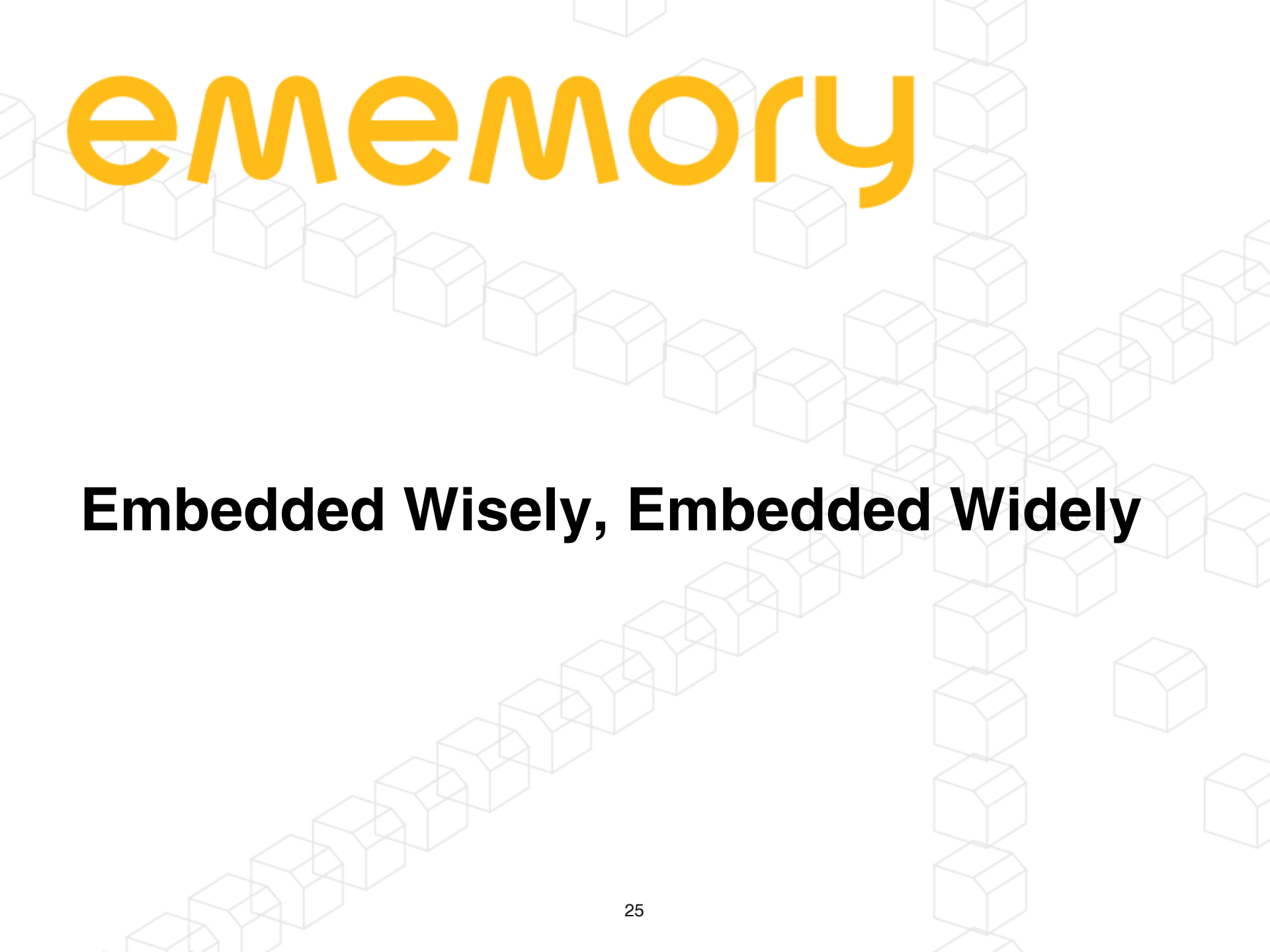
- 公司簡介
- 公司產品佈局
- 營運概況
- 主要產品應用
- 未來展望

2014 – 2016 成長動能



總結

- 力旺電子提供完整的LOGIC NVM矽智財產品線
- 使用力旺電子之矽智財晶片年量產數持續成長
- 展望未來三年，力旺在NVM IP之普及率與新產品應用之滲透率將持續發酵，營收將持續成長。



ememory

Embedded Wisely, Embedded Widely